

ك/رقم.....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Ministère de l'enseignement
Supérieur et de la recherche
Scientifique
ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Vieux -kouba (ALGER)
Département de physique

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المدرسة العليا للأساتذة

القبة القديمة (الجزائر)

قسم الفيزياء



مذكرة بعنوان:

خصائص صمام السلسيلوم لتضخيم الضوئي (SiPM)

مذكرة لنيل شهادة أستاذ التعليم الثانوي

تحت إشراف الأستاذ:

- بوساحة بوزيد

إعداد الطلبة:

❖ موساوي خالد

❖ نوال يوسف

❖ هبول إسماعيل

لجنة المناقشة:

الأستاذ: مولاي نصر الدين رئيسا.

الأستاذ: بيطام طارق ممتحنا.

الأستاذ: بوساحة بوزيد مشرفا.

السنة الدراسية: 2015/2014

دفعـة جوان 2015

الفهرس

.....	الاهداء
.....	كلمة شكر
1.....	مقدمة.....
	الفصل الأول: أشباه النوافل والوصلة pn
2.....	I) نظرة على أشباه النوافل.....
2.....	1.I) تعريف اشباه النوافل.....
2.....	2.I) اشباه النوافل النقية.....
2.....	3.I) النوافل، العوازل واسباب النوافل.....
3.....	2.I) ذرة السلسيلium.Si.....
4.....	3.I) بلورة السلسيلium.....
5.....	4.I) مفهوم الفجوة.....
7.....	5.I) تطعيم اشباه النوافل.....
7.....	1.5.I) شبه الناقل الموجب type-p
9.....	2.5.I) شبه الناقل السالب type-n
11.....	6.I) الحركية في اشباه النوافل.....
12.....	7.I) ناقلية ومقاومة شبه الناقل.....
13.....	8.I) ثانوي الوصلة pn
14.....	1.8.I) ثانوي الوصلة pn عند الاستقرار
15.....	2.8.I) ثانوي الوصلة عند تطبيق جهد خارجي
17.....	9.I) كثافة الشحنة الفراغية
18.....	10.I) الحقن والكمون الكهربائيان
20.....	11.I) الصمام الضوئي
21.....	1.11.I) طريقة العمل
21.....	2.11.I) استخدامات الصمام الثنائي
22.....	12.I) الخلية الكهرو ضوئية

22.....	(13.I) اهم اوجه التشابه ولاختلاف.....
22.....	(14.I) الخلاصة.....

الفصل الثاني: دراسة نظرية لجهاز لا SiPM

23.....	(1.II) تعريف صمام السلسيلوم للتضخيم الضوئي SiPM
24.....	(2.II) تبرير فوائد الاستعمال SiPM
25.....	(3.II) مبدأ عمل SiPM
26.....	(1.3.II) عد الفوتونات ووقت تسجيلها
26.....	(2.3.II) التشبع
27.....	(4.II) خصائص SiPM
27.....	(1.4.II) الربح (Gain)
28.....	(2.4.II) كفاءة كشف الفوتون
30.....	(3.4.II) الضجيج
30.....	noise of optical cross-talk (4.4.II)

الفصل الثالث: دراسة تطبيقية على جهاز الا SiPM

32.....	(1.III) خصائص SiPM المستعملة في الاختبار
33.....	(1.1.III) إختبار التشغيل
34.....	(2.1.III) نظام القراءات
35.....	(2.III) إضاءة LED
36.....	(3.III) غرفة المناخ و قراءات درجة الحرارة
36.....	(4.III) نظام الحصول على البيانات
37.....	(5.III) منهجية التحليل
37.....	(1.5.III) قياس طيف photo-electron الواحد
39.....	(6.III) قياس الربح
40.....	(7.III) خصائص الا SiPM في حالة الاشتغال
41.....	(1.7.III) حساب المقاومة R_q الخاصة بكل بكسل
42.....	(2.7.III) حساب الشحنة Q

42.....	حساب الربح gain (3.7.III)
42.....	حساب جهد الانهيار Vbd (4.7.III)
43.....	حساب Cd(F) (5.7.III)
43.....	حساب tau (6.7.III)
.44.....	حساب البعد d (6.7.III)
45.....	الخاتمة

قائمة الاشكال

الفصل الاول

الشكل(I-1): التمثيل الحزمي لمختلف أنواع المواد.....	3.....
الشكل(I-2) ذرة السليسيوم.....	4.....
الشكل (I-3) الغلاف الخارجي لذرة السليسيوم	4.....
الشكل(I-4) الذرة بداخل البلورة	5.....
الشكل(I-5) إنتاج الفجوات.....	5.....
الشكل(I-6) حركة الفجوات	7.....
الشكل (I-7) مكونات التيار.....	7.....
الشكل(I-8): شبه الناقل -type-p-	8.....
الشكل (I-9): مستويات الطاقة لشبہ الناقل -type-p-	9.....
الشكل (I-10) شبه ناقل-type-n-	10.....
الشكل(I-11) مستويات الطاقة لشبہ الناقل type-n	10.....
الشكل(I-12): الحرکیۃ بدلالۃ الزمن.....	11.....
الشكل(I-13) التركیب و الرمز الالکترونی لثنائی الوصلة	13.....
الشكل(I-14): الوصلة pn	14.....
الشكل(I-15): تركیز الالکترونات و الفجوات	14.....
الشكل(I-16): منطقۃ الاستنزاف فی الوصلة pn	15.....

الشكل(I-17) :الإنحياز العكسي.....	16.....
الشكل(I-18) :الانحياز المباشر.....	16.....
الشكل (I-19) مخطط يبين مستويات الطاقة قبل اتصال شبهى الناقلين n و p.....	17.....
الشكل(I-20) مخطط يبين مستويات الطاقة بعد اتصال شبهى الناقلين n و p.....	17.....
الشكل(I-21): يمثل عرض منطقة الشحنة المفرغة.....	18.....
الشكل(I-22):يتمثل الكثافة بدالة X في المنطقة المفرغة.....	18.....
الشكل(I-23):الحقل الكهربائي بدالة X في المنطقة المفرغة.....	18.....
الشكل(I-24):رسم تخطيطي يوضح الصمام الثنائي.....	20.....
الشكل(I-25):التوصيل العكسي للصمام الثنائي.....	20.....
الشكل(I-26):استخدامات الصمام الضوئي.....	21.....

الفصل الثاني

الشكل(II-1):الكافش.....	24.....
الشكل(II-2) : APD	24.....
الشكل (II-3):الإلكترونات و الفجوات في وضع جيجر	25.....
الشكل (II-4): دالة الجهد العكسي المطبق والريح.....	28.....
الشكل(II-5):نبض الكشف عن كل فوتون.....	28.....
الشكل (II-6) : كدالة الطول الموجي لـPixel مختلفة	29
الشكل(II-7): العلاقة بين الطول الموجي و Pixel ResponsivityPixel Responsivity	29.....
الشكل (9-2) : Crosstalk	31.....

الفصل الثالث

- الشكل(1-III) : صور ل PCB بالإضافة إلى SiPM في مربع أسود داخل غرفة المناخ على اليسار و غرفة المناخ سويا لعداد القياس على اليمين.....35.....35.....
- الشكل(2-III) : مخطط لنظام القياس مع مضخم BGA614
- الشكل(3-III) : الشكل الموجي ل photo-electron (اليسار) و طيف photo-electron (اليسار) مقاسة ب 38.....S10943_8584 (اليمين)
- الشكل(4-III) : اليسار: طيف ال photo-electron المقاس ب MPPC #11759 وعلى اليمين طيف ال photo-electron المقاس ب CPTA #857. كل من الطيفين أخذ في نفس درجة الحرارة والجهد كما هو الحال في الشكل (3-III)، توزيع PDF باللون الأحمر و قمم 40..... Gaussian باللون الازرق.....
- الشكل (5-III) : تغيرات جهد الانحياز V_{bias} بدلالة شدة التيار .41.....
- الشكل (6-III) : تغيرات الريح G بدلالة الجهد العكسي V_{bias} 43.....

الفهرس الجداول

الجدول(I-1) بعض القيم لأهم خصائص كل من Ge و Si.....	20
الجدول(1-III): خصائص بعض SiPM.....	33
جدول (2-III): النتائج المحصل عليها من الحسابات السابقة	44

المقدمة

تتمتع المواد نصف ناقلة بعده من الخواص يجعلها من أكثر الأجسام الصلبة أهمية في العديد من التطبيقات، وإن الأجهزة الفيزيائية التي تستخدم أنصاف النوافل لتدشين بدء تنويعها و اختلافها، وما زالت هذه المواد تدخل حقولاً جديدة من التطبيقات العملية، وإذا كانت دراستها قد بدأت منذ عام 1920 إلا أنها لم تحظى بالاهتمام الفائق إلا بعد اختراع الترانزistor (1949) وتواصل التطور منذ ذلك الحين إما على صعيد دراسة الخواص الأساسية والتعويق في فهمها أو في استخدام هذه الخواص في اختراع وتصميم أجهزة وتطبيقات جديدة.

من بين الأجهزة التي اعتمدت على هذه المادة هو صمام السليسيوم للتضخيم الضوئي SiPM، واستشعاراً منا لأهمية هذا الموضوع حاولنا البحث فيه حيث قسمنا هذا العمل المترافق مع ثلاثة فصول :

الفصل الأول : يشمل دراسة نظرية لأنشاء النوافل والوصلة p-n

الفصل الثاني : يشمل دراسة صمام السليسيوم للتضخيم الضوئي SiPM.

الفصل الثالث : إلى دراسة خصائص جهاز SiPM.